J-PARC MRアップグレードのための 新しい入射セプタム電磁石の開発(2)

<u> 芝田達伸(KEK)</u>

川口祐介、中村健太、石井恒次、杉本拓也、 松本浩、松本教之、Fan Kuanjun KEK、ニチコン(株)、HUST

2016年8月9日(火) 電磁石と電源2 TUOL09







MR用入射電磁石 *1Hz化のためにアップグレードが必要*

MR 用入射電磁石

入射電磁石 = RCSからMR周回ラインに入射する電磁石



本講演はセプタム電磁石 I について



前回の報告 入射セプタム I のインストールは2015年

→ トラブルにより1年延期

新入射セプタムIのトラブル



<u>新入射セプタム I のトラブル(1)</u>

2015年8月 真空ダクトで真空漏れ発生



出射側大フランジを真空ダクトに 溶接した直後に発生

<u>大フランジとダクトの接続箇所の図面</u>



四隅は傾きのある側面-上(底面)-フランジ3点交差 + 真空側からの溶接



<u>真空ダクトの再製作が必要 = インストール延期</u> 入射ダクト+周回ダクト両方

7

新入射ダクトへの改善

ダクト出射部に溶接ベローズを使用 溶接ベローズ面と大フランジ面は平行 アラインメント調整がしやすい 入射ダクトと溶接ベローズが斜め接続になる

■ 入射ダクトと溶接ベローズ間にシームレス管を挟む 1つの塊をくり抜いた継ぎ目のない管 四隅の3点交差の欠陥を回避できる



2016年3月 真空ビームダクト完成





性能評価項目



■積分磁場の平坦度調整

■ 電流と磁場の ショット毎の再現性と長時間の安定性測定

磁極内磁場分布と積分磁場





11

周回ダクトへの改善

漏れ磁場軽減のため 材質をSUS316L製からSUY製に変更

<u> 周回ラインへの磁気遮蔽 (SUY3重遮蔽)</u>



周回ラインへの漏れ磁場測定(2)



結果:磁場1Gauss以下、積分磁場1Gauss m以下

周回ラインへの漏れ磁場測定(3)



結果:磁場3Gauss以下、積分磁場4Gauss m以下

積分磁場の平坦度調整(1)

14

入射時間120msecの積分磁場の平坦度への要求値 = 5 × 10⁻⁵ 入射セプタム I はパターン波形出力電源を使用する → パターン波形で平坦度を調整

<u>平坦度調整(1) 完全平坦パターンを使用(例:3400A出力)</u>



入射ダクト表面で発生した渦電流による磁場の影響で平坦度は悪い.



<u>平坦度調整(2) 渦電流補正型パターン波形を決める.</u> 渦電流効果を打ち消す程度に電流値を増加させる



結果:全電流値で5×10⁻5以下の平坦度





結果1:再現性、安定性ともに10-4以下 磁場と電流値の結果の違いは磁場の測定精度と推測

まとめと今後

- 1. 新入射セプタム電磁石 I のインストール延期 新入射+周回ビームダクト製作
- 2. 磁場測定

結果2-1 磁極内磁場は仕様を満たす. 結果2-2 3重遮蔽により漏れ磁場軽減に成功 結果2-3 積分磁場の平坦度を10⁻⁵台に調整 結果2-4 電流値、磁場の再現性と安定性は10⁻⁴以下 性能は十分要求を満たしている

